

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 398921 (22) 2012 04 23

(51) H01B 17/30 (2006.01)

F16L 5/08 (2006.01)

H01R 4/32 (2006.01)

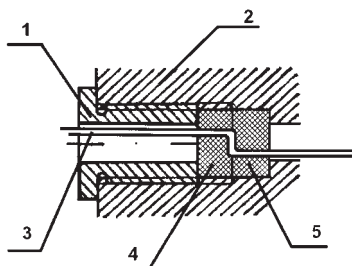
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) KRAWCZYK SŁAWOMIR

(54) Przepust kablowy

(57) Przepust kablowy zbudowany jest z obudowy (2) w kształcie tulei posiadającej gwint wewnętrzny, dwóch uszczelki oporowej (5) i dociskowej (4) i śruby dociskającej (1) z otworem centrycznym. Uszczelki (4 i 5) posiadają otwory w różnej odległości od swojej osi. Otwór w uszczelce dociskowej (4) jest w zakresie średnicy otworu centrycznego śruby dociskającej (1) a otwór w uszczelce oporowej (5) jest w zakresie otworu obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 398993 (22) 2012 04 26

(51) H01L 35/14 (2006.01)

H01L 35/34 (2006.01)

C03C 8/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) GODLEWSKA ELŻBIETA; NOCUŃ MAREK; MAJEWSKA-ZAWADZKA KINGA; MARS KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych

(57) Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych charakteryzuje się tym, że sporządza się zestaw surowcowy zawierający następujące tlenki w % wagowych: 30,0-60,0 SiO₂, 10,0-16,0 Na₂O, 12,0-18,0 TiO₂, 2,0-7,0 K₂O, 5,0-10,0 Al₂O₃, 0-5,0 ZnO, 0,5-2,5 P₂O₅, 0-1,5 CuO, 0-1,0 CoO oraz 0-1,0 MoO₃. Mieszanke topi się w temperaturze 900-1300°C na jednorodną masę, którą frytuje się, po czym uzyskaną frytę mieli na proszek o uziarnieniu 10-60 μm i nanosi go na materiał termoelektryczny znanymi metodami. Następnie powłokę wypala się w temperaturze 650-750°C przez 2-7 minut. Korzystnie do otrzymanego poprzez zmielenie fryty proszku wprowadza się dodatki, których zawartość w suchej masie wynosi do 12% wagowych, przy czym jako dodatki stosuje się SiO₂ w ilości 0-5% wagowych, Cr₂O₃ w ilości 0-2% wagowych oraz glinę w ilości 0-5% wagowych. Proszek wraz z dodatkami mieli się w młynie kulowym na mokro przez 1-5 godzin, po czym kompozycję w postaci zawiesiny nanosi na materiał termoelektryczny metodą mokrą.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398975 (22) 2012 04 25

(51) H01M 4/06 (2006.01)

H01M 4/36 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) KIERZEK KRZYSZTOF; MACHNIKOWSKI JACEK; BEGUIN FRANCOIS, FR

(54) Sposób otrzymywania pyłowego materiału kompozytowego do wytwarzania anody ogniwa litowo-jonowego oraz sposób wytwarzania ogniwa z wykorzystaniem wspomnianego materiału

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania pyłowego materiału kompozytowego do wytwarzania anody ogniwa litowo-jonowego oraz sposób wytwarzania ogniwa z wykorzystaniem wspomnianego materiału.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398853 (22) 2012 04 17

(51) H02H 5/04 (2006.01)

H02H 7/10 (2006.01)

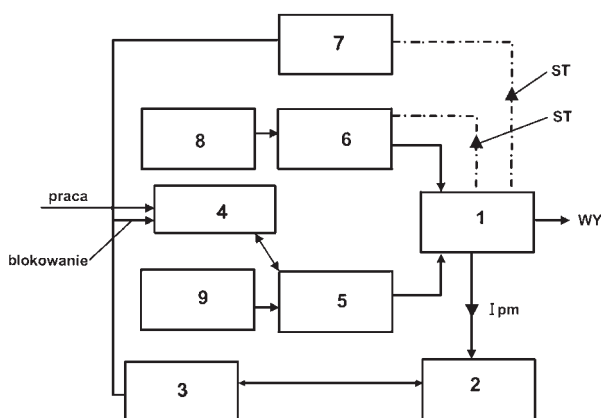
(71) CET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna

(72) SZUPRYCIŃSKI JACEK; ZIELKE KAROL

(54) Sposób i układ zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciovego transformatora elektronicznego

(57) Sposób zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciovego transformatora elektronicznego polega na tym, że sprzężenie termiczne (ST) występujące pomiędzy co najmniej jedną diodą układu półmostka (1) i kolektorem tranzystora klucza tranzystorowego (6), a co najmniej jednym termistorem bloku termicznego (7) emituje przepływ ciepła z diody w kierunku termistora sterując wartością jego rezystancji proporcjonalnie do wartości prądu (I_{pm}) przepływającego przez półmostek (1) oraz równocześnie emituje przepływ ciepła z diody w kierunku tranzystora klucza tranzystorowego (6) utrzymując jego wyższą temperaturę w odniesieniu do temperatury tranzystora (T₂) układu wyzwalania diaka (3), zmieniając ją proporcjonalnie do wartości prądu (I_{pm}). Układ składa się z układu półmostka (1), na którym wzrost obciążenia na wyjściu (WY) transformatora powoduje zwiększony przepływ prądu (I_{pm}) i wystąpienie ujemnego napięcia na połączonych z układem półmostka (1) rezystorach układu pomiarowego (2), które poprzez blok układu wyzwalania diaka (3) i układ wyzwalania klucza tranzystorowego (4) steruje pracą klucza tranzystorowego (5), z kolei układ półmostka (1) połączony jest równoległym sprzężeniem termicznym (ST) z kluczem tranzystorowym (6) oraz z blokiem termicznym (7).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 398916 (22) 2012 04 23

(51) H02H 7/26 (2006.01)

H02H 3/24 (2006.01)

H02H 5/00 (2006.01)